

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19086

Цена в прайсе: 154 тг.

MOSFET транзистор FQPF8N80C, N-канал, 800 В, 8 А, TO-220F



FQPF8N80C — высоковольтный N-канальный MOSFET транзистор на **800 В** и **8 А** в полностью изолированном корпусе **TO-220F**. Максимальное сопротивление открытого канала — **1,55 Ом** при $V_{GS}=10$ В. Предназначен для импульсных блоков питания, PFC-корректоров и другой силовой электроники.

FQPF8N80C — силовой N-канальный MOSFET семейства QFET, первоначально разработанный Fairchild Semiconductor и выпускавшийся под брендом onsemi. Транзистор рассчитан на напряжение сток-исток до **800 В** и постоянный ток стока до **8 А** при температуре корпуса **25 °C**.

Модель выполнена по DMOS-технологии и оптимизирована для снижения сопротивления открытого канала и коммутационных потерь. Максимальное $R_{DS(on)}$ составляет **1,55 Ом** при токе 4 А и напряжении затвор-исток 10 В. Типовой полный заряд затвора — **35 нКл**, что позволяет применять транзистор в высокочастотных импульсных преобразователях.

Корпус **TO-220F** имеет электрически изолированную заднюю поверхность, что упрощает монтаж транзистора на радиатор и снижает риск электрического контакта между металлическим теплоотводом и силовой цепью. Для версии FQPF8N80C максимальная рассеиваемая мощность при температуре корпуса 25 °C составляет **59 Вт**.

FQPF8N80C подходит для импульсных источников питания, корректоров коэффициента мощности PFC, электронных балластов, преобразователей напряжения и другой высоковольтной силовой электроники.

Характеристики

- Производитель: **Fairchild Semiconductor / onsemi**
- Модель: **FQPF8N80C**
- Тип: силовой MOSFET
- Канал: **N-канальный**
- Режим: Enhancement
- Максимальное напряжение сток-исток VDS: **800 В**
- Постоянный ток стока ID при 25 °C: **8 А**
- Постоянный ток стока при 100 °C: **5,1 А**
- Импульсный ток стока IDM: **32 А**
- Максимальное напряжение затвор-исток VGS: **±30 В**
- Пороговое напряжение затвора VGS(th): **3-5 В**
- RDS(on): **1,29 Ом тип., 1,55 Ом макс.**
- Условия RDS(on): VGS=10 В, ID=4 А
- Полный заряд затвора Qg: **35 нКл тип., 45 нКл макс.**
- Входная ёмкость Ciss: **1580 пФ тип., 2050 пФ макс.**
- Выходная ёмкость Coss: **135 пФ тип.**
- Обратная передаточная ёмкость Crss: **13 пФ тип.**
- Время включения td(on): **40 нс тип.**
- Время выключения td(off): **65 нс тип.**
- Импульсная лавинная энергия EAS: **850 мДж**
- Максимальная рассеиваемая мощность: **59 Вт**
- Тепловое сопротивление переход-корпус: **2,66 °C/Вт**
- Диапазон температуры перехода: **-55...+150 °C**
- Корпус: **TO-220F**
- Количество выводов: **3**
- Монтаж: **ТНТ / выводной**
- Распиновка: **1 — Gate, 2 — Drain, 3 — Source**